

Jullière 1975

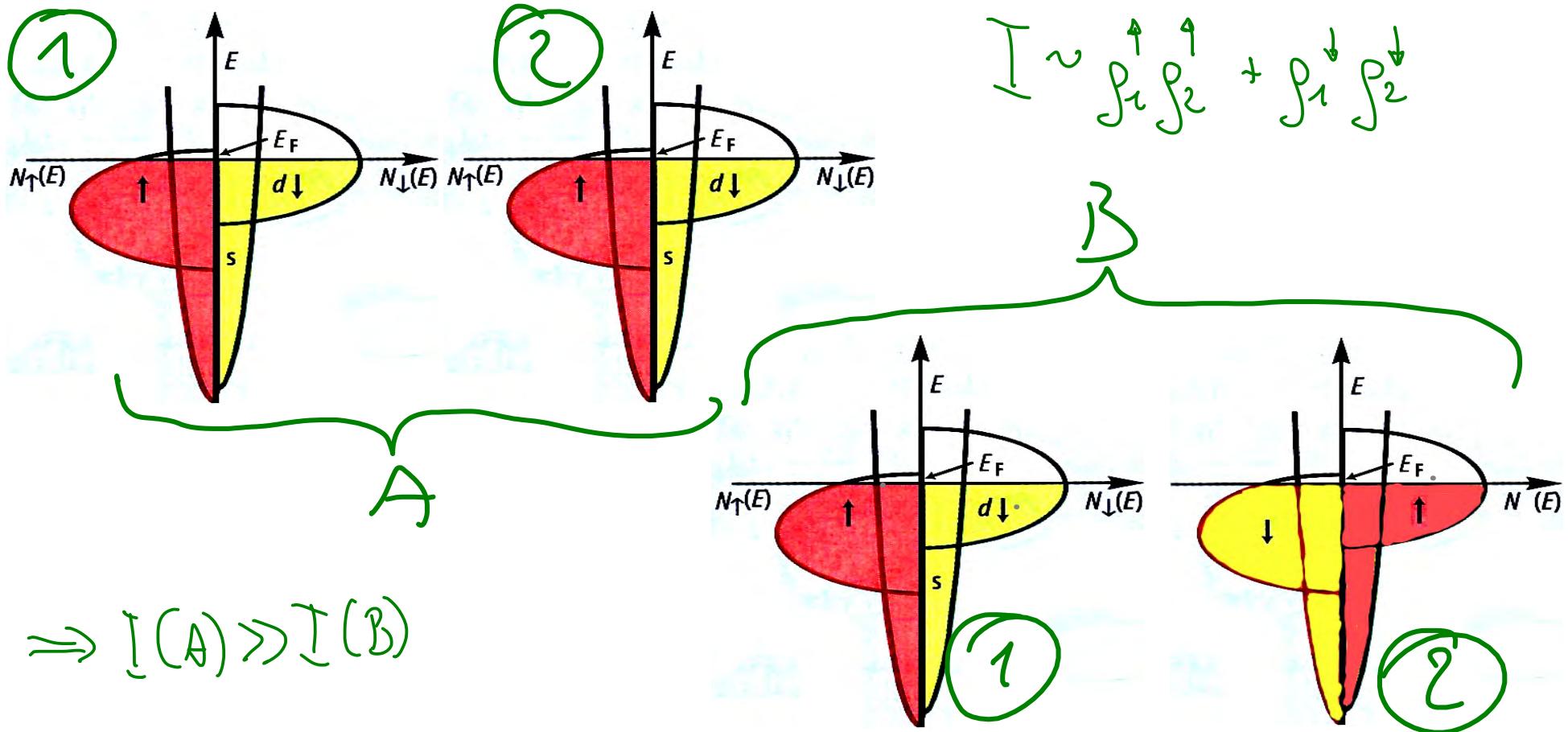
Tunneln zwischen 2 Ferromagneten über Barriere

Resultat: R hängt von Orientierung oder  
Magnetisierung ab.

$$\text{TMR} := \frac{R_{AP} - R_p}{R_p}$$

tunneling magneto resistance (ratio)

# Jullièremodell



wenig beachtet, weil Effekt klein  
und schwer reproduzierbar

70er :

Kopplung über leitende Zwischenschichten

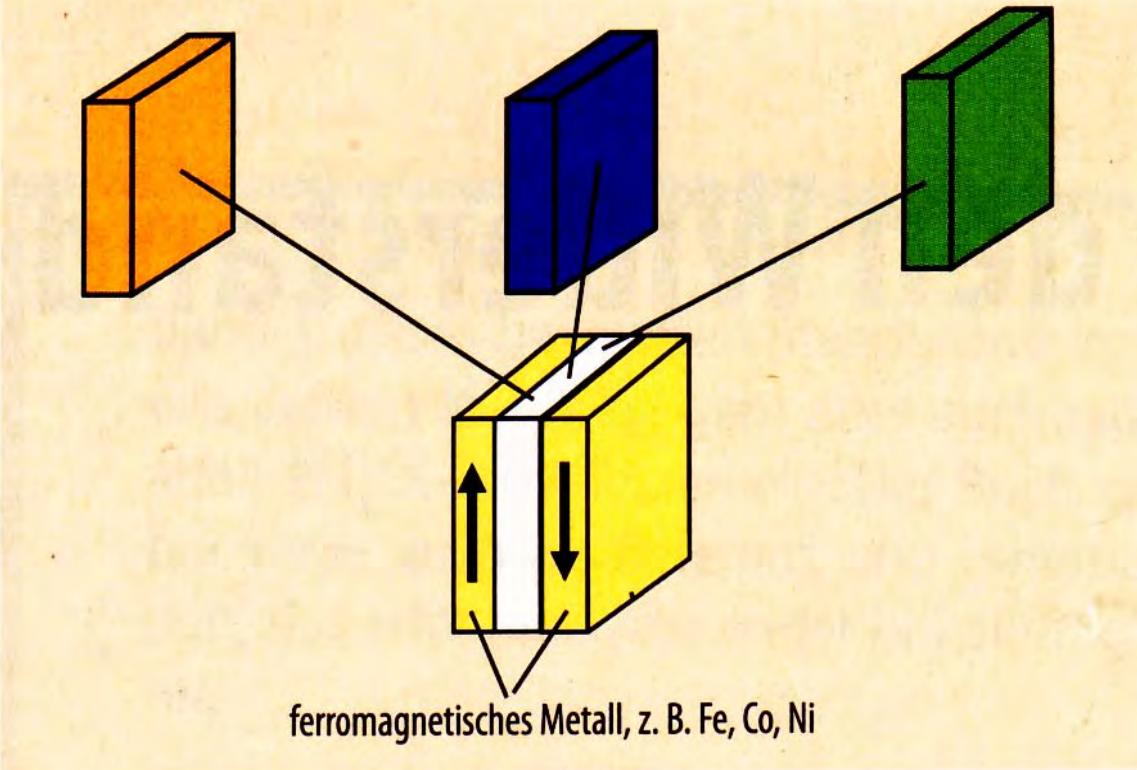
- Metalle: RKKY, oszillatorisch
- auch für HL wie Si

aber: wenig TMR  
(vermutete Ursache: Defektzustände)

Metall, z. B. Ag, Cr

Halbleiter, z. B. Si

Isolator, z. B. MgO



**Abb. 1** Die hier betrachteten Strukturen bestehen aus mindestens zwei ferromagnetischen Schichten mit einer typischen Dicke von rund 10 nm, die durch eine nichtferromagnetische, etwa 1 nm dicke Zwischenschicht getrennt sind.

anisotropic  
magnetoresistance

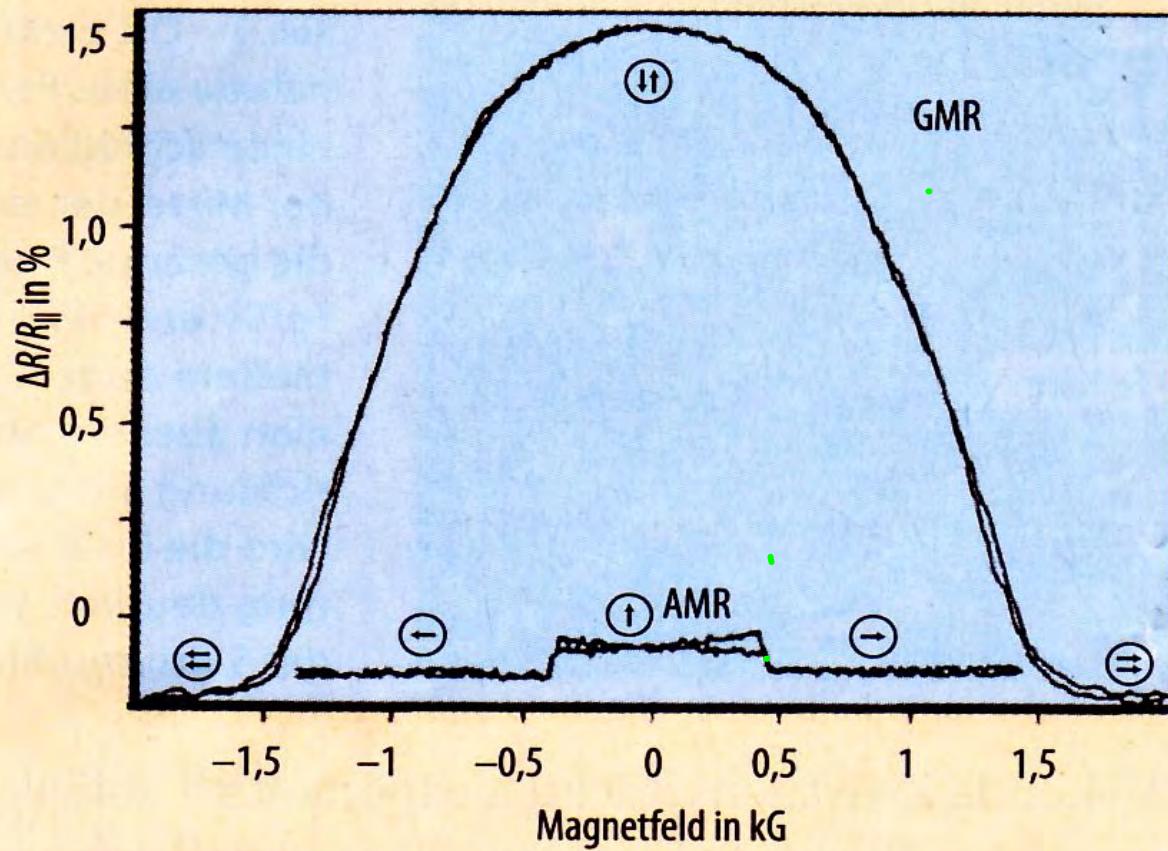


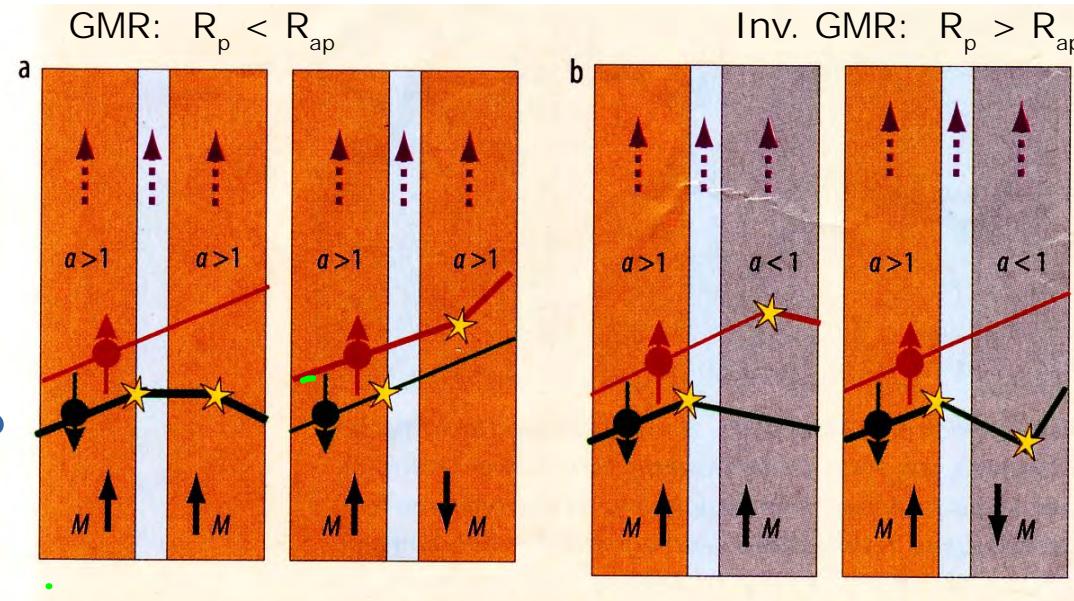
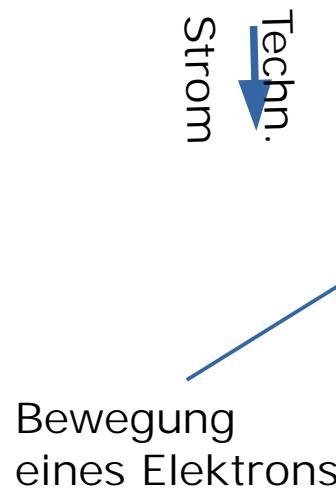
Abb. 4 Der GMR-Effekt im Dreilagensystem Fe/Cr/Fe (Schichtdicke des Eisens: 12 nm) ist im Vergleich zum AMR-Effekt eines 25 nm dicken Fe-Films deutlich ausgeprägter.

System	$\Delta R/R_p$ in %	$t_{mag}$ in nm
Fe/Cr/Fe	1,5	12
Fe/Cr/Fe	2	5
[Fe/Cr(1,2 nm)]50	42	0,45
Co/Cu/Co	2,0	10
Co/Cu/Co	19	3
[Co/Cu(0,9 nm)]30	48	1,5
Co90Fe10/Cu/Co90Fe10	6	0,8
Co/Cu/Co	16	2,8
[Co/Cu(0,9 nm)]16	65	1

$$\alpha = \rho_{\downarrow} / \rho_{\uparrow}$$

Idee: Nur e- mit "falschem" Spin werden gestreut

## Streuasymmetrie



**Abb. 5** In dem hier gezeigten idealisierten Modell werden je nach magnetischem Material und Grenzfläche nur Elektronen mit Spin down ( $\alpha > 1$ ) oder Spin up ( $\alpha < 1$ ) gestreut (Streuprozesse sind durch Sterne markiert). Ist  $\alpha$  in beiden Schichten kleiner bzw. größer als 1, führt dies zum normalen GMR-Effekt (a). Die Kombination von  $\alpha > 1$  und  $\alpha < 1$

führt zum inversen GMR-Effekt (b), bei dem  $R_p > R_{ap}$  ist. Spinabhängige Grenzflächenreflektivität ist nicht dargestellt, da sie wegen der Translationssymmetrie in der Schichtebene den Elektronenimpuls in Stromrichtung nicht verändert. Für Ströme senkrecht zur Schichtebene trägt neben der Streuung auch die Reflexion zum GMR-Effekt bei.

Mittlerweile lassen sich bessere  
Tunnel barrieren herstellen.

insbesondere :  $\text{MgO}$

zeigt viel TMR

⇒ jetzt TMR-Sensoren

Jullières  
System

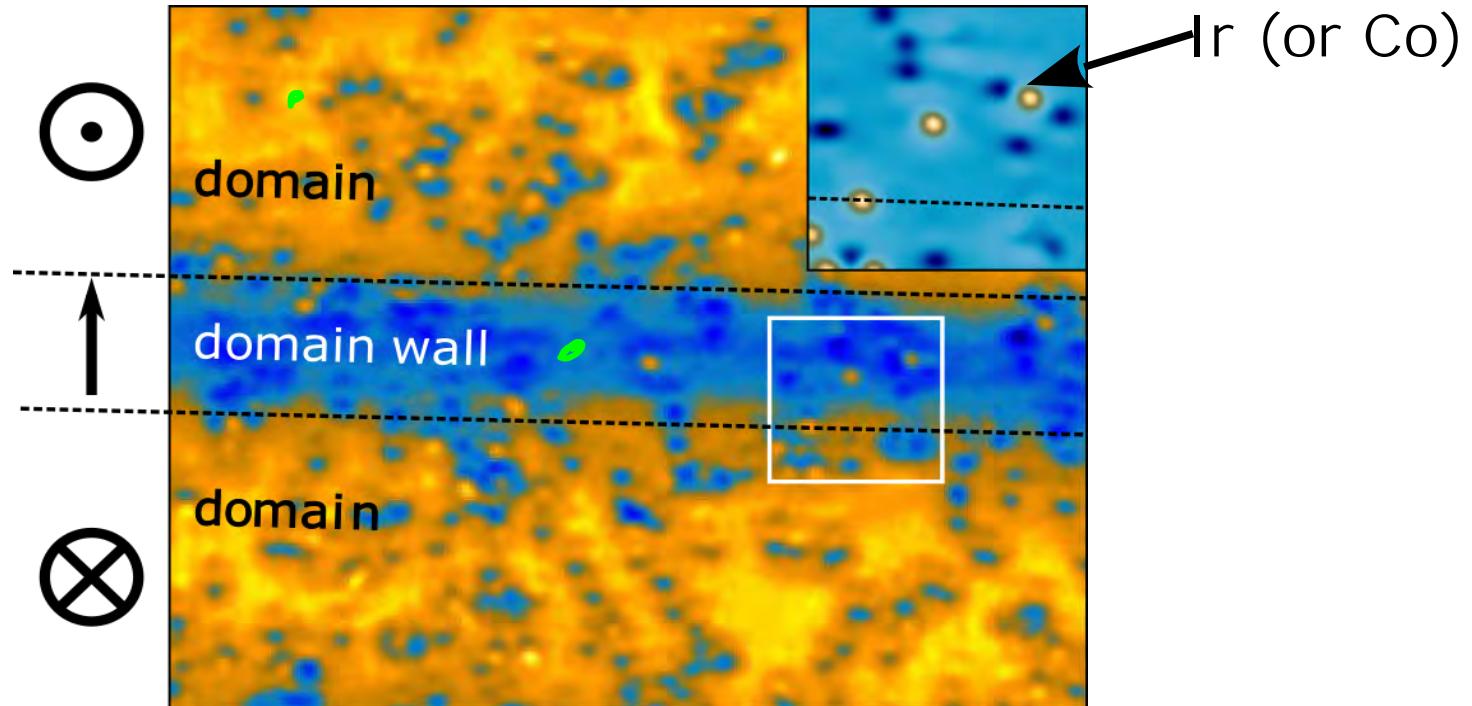
Struktur	$U - E_F$ in eV	$\Delta R/R_p$ in %
Co/Ge(10 nm)/Co		16 (4,2 K)
CoFe/ZnS/CoFe	0,580	5 (270 K)
	0,565	10 (6 K)
Fe/GaAs/Fe		1,55 (300 K)
CoFeB/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /CoFeB		70 (300 K)
CoFeB/MgO/CoFeB		472 (300 K)
		804 (5 K)
CoFe/MgO/CoFe	1,1 ... 1,7	220 (300 K)
		300 (4,2 K)
Fe/MgO/Fe	0,37 ... 0,40	180 (300 K)
Fe/Si/Fe	0,3 ... 0,8	≈ 0

Tab. 1 Der TMR bei verschiedenen Materialkombinationen [7]. In Klammern steht die Temperatur, bei der der TMR gemessen wurde. Die Barrierenhöhe  $U - E_F$ , die dem Abstand der unteren Kante des Leitungsbandes  $U$  vom Fermi-Niveau  $E_F$  entspricht, ist ein Maß für die isolierenden Eigenschaften der Zwischenschicht.

# Ir (& Co) on Fe bilayer on W(110)

Tunneling Anisotropic MR of Co: Néel et al., PRL 110, 037202 (2013)

Here: heavy Ir, contact, W tip, no magnetostriction



$dI/dV$  map at 70 mV,  $52 \times 42 \text{ nm}^2$

$$\text{AMR} = (G_{\text{domain}} - G_{\text{wall}}) / G_{\text{domain}}$$

# Interface-induced phenomena in magnetism

Rev. Mod. Phys. 89, 025006 (2017)

Enthält auch sehr lesbare Zusammenfassung von 3d-Magnetismus

Relevante Energien:

Austausch-WW (Pauli P. beeinflusst Coulomb-WW)

Kristallfeld-WW (lokales E beeinflusst Psi)

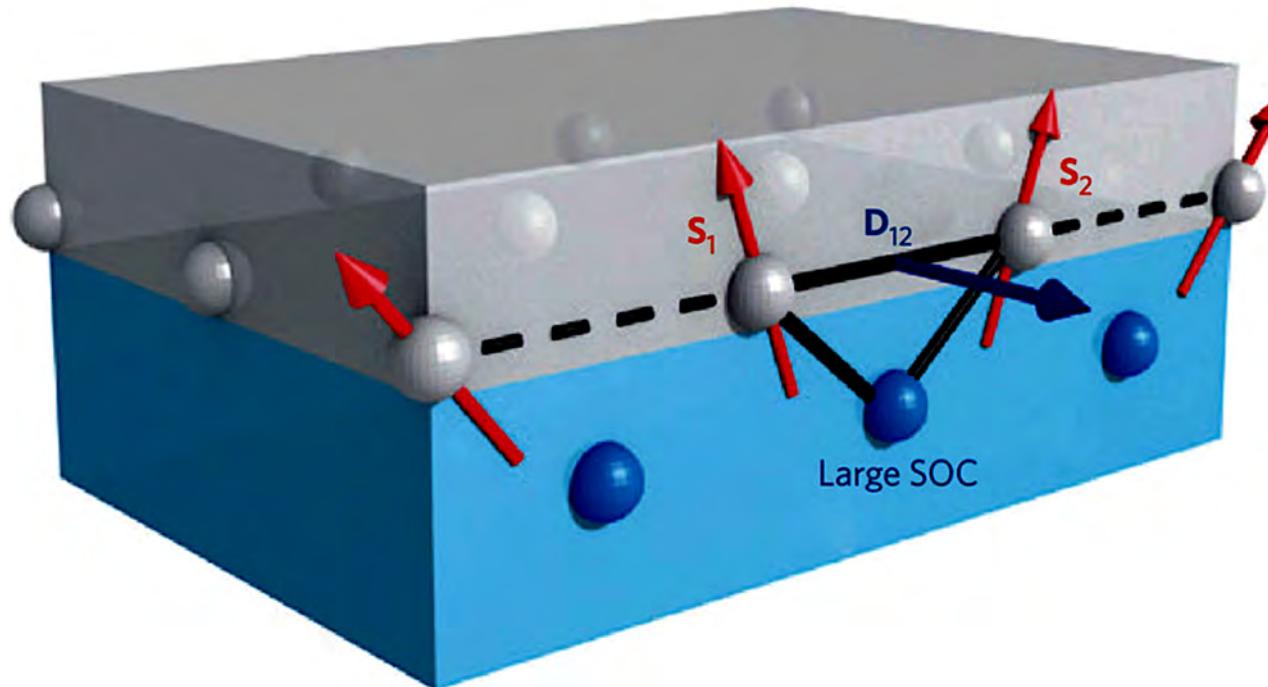
LS-Kopplung

Dipol-Dipol-WW

# 3-site mechanism generating an interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction

ferromagnet

large spin-  
orbit coupling



Spins  $S_1$  &  $S_2$  in the FM couple through wave function overlap with large SOC atom.

Result: energy term  $D_{12} \cdot (S_1 \times S_2)$  with  $D_{12}$  lying in the interface plane & normal to the three-atom plane

# Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung

$$\begin{aligned} d\mathbf{M}/dt &= -\gamma_0 \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} + \frac{\alpha}{M_s} \mathbf{M} \times d\mathbf{M}/dt \\ &= -\gamma'_0 \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} - \frac{\alpha\gamma'_0}{M_s} \mathbf{M} \times (\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}) \end{aligned}$$

$\gamma_0 = \mu_0 \gamma$ ,  $\gamma$  is the gyromagnetic ratio  $g\mu_B/\hbar$

$\alpha$  is the Gilbert damping parameter

$\mathbf{H}_{\text{eff}} = -(1/\mu_0) \nabla_M E(\mathbf{M})$  effective field (has contributions from all terms that contribute to the energy density of the magnetization  $E(\mathbf{M})$ , including interaction with an applied field, interatomic exchange, magnetostatic dipole-dipole interaction, magnetocrystalline anisotropy, and Dzyaloshinskii-Moriya interaction)

1<sup>st</sup> part of Eq. is written with the damping in the Gilbert form (2004), 2<sup>nd</sup> is in the original Landau-Lifshitz form (1935). They are equivalent with the substitution  $\gamma_0' = \gamma_0 / (1 + \alpha^2)$ .